

2X26W 双声道、D类、超低底噪、可设置升压音频功率放大器

特性

- 输入电压范围: 2.8V~ 13V
- 10A 集成大电流异步电感式升压
- 适用于单、双、三节锂电输入升压
- 超低底噪: 85uV
- 输出功率
3.7V升压到9V:
at 10% THD+N
– 11W, at $V_{IN}=3.7V$, $R_L=4\Omega$
at 1% THD+N
– 9W, at $V_{IN}=3.7V$, $R_L=4\Omega$
- 7.4V升压到14.5V:
at 10% THD+N
– 25W, at $V_{IN}=7.4V$, $R_L=4\Omega$
at 1% THD+N
– 24W, at $V_{IN}=7.4V$, $R_L=4\Omega$
- 12V升压到14.5V:
at 10% THD+N
– 26W, at $V_{IN}=12V$, $R_L=4\Omega$
at 1% THD+N
– 25W, at $V_{IN}=12V$, $R_L=4\Omega$
- 可选改善EMI的扩频模式
- 关断电流 < 10uA
- 过热保护功能
- 满足ROHS要求的环保封装

应用

- 各种蓝牙音箱、智能音箱
- 扩音器、扬声器设备
- 各种消费类音频产品

说明

LTK54103 是一款适用于单、双节、三节锂电升压的大功率、可设置升压、立体声、高效率、无滤波器的D类音频功率放大器。

单节锂电供电情况下, 在 4Ω 下可以达到 $2\times 11W$ (10% THD+N); 双节锂电供电情况下, 在 4Ω 下可以达到 $2\times 25W$ (10% THD+N), 三节锂电供电情况下, 在 4Ω 下可以达到 $2\times 26W$ (10% THD+N)。

LTK54103带有可选的扩频功能,可以有效降低开关频率对EMI的影响。

LTK54103根据需求设置输入限流电流,可以匹配不同电源电池和输出功率的要求。

典型应用原理图

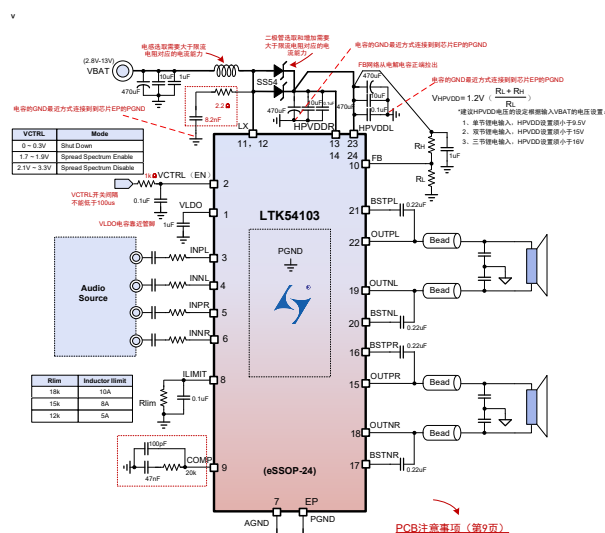
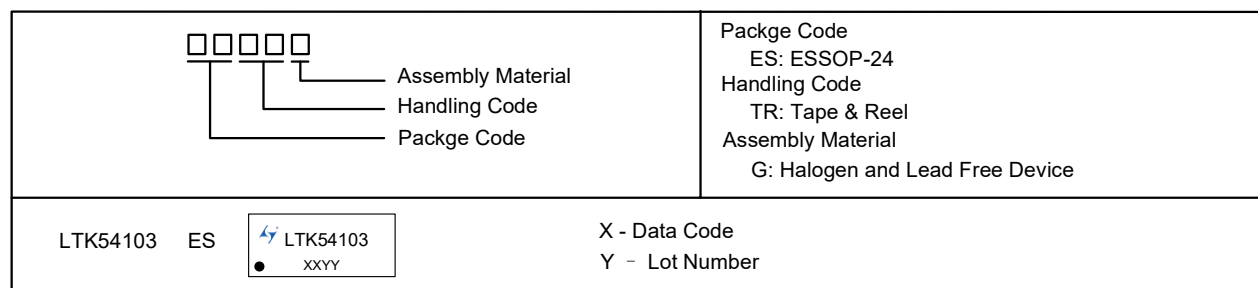


图1. LTK54103应用原理图

Order and Marking Information



Note: LTKCHIP 保留作出更改以改善可靠性或可制造性，并建议客户在下订单前参考最新版本的相关资料。

管脚说明

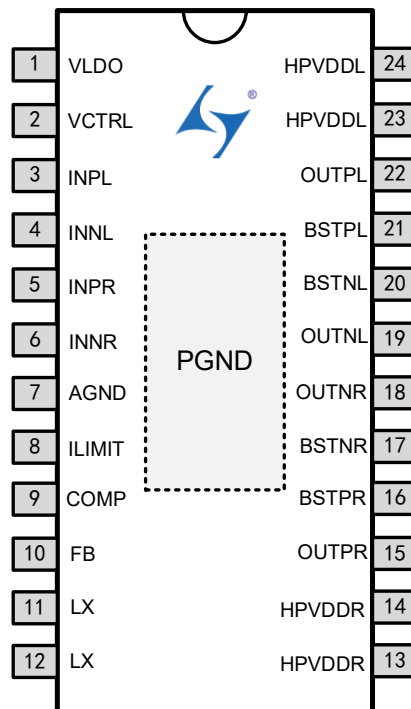


图2. LTK54103管脚说明

管脚功能

序号	名称	IO	功能说明
1	VLDO		对地偏置电源电压, 为内部电路和逻辑电路提供电压, 需要连接1uF电容到地。
2	VCTRL	I	使能模式控制输入, 包含关闭、扩频、扩频关闭模式。
3	INPL	I	左通道正端音频输入
4	INNL	I	左通道负端音频输入
5	INPR	I	右通道正端音频输入
6	INNR	I	右通道负端音频输入
7	AGND	P	模拟地
8	ILIMIT	I	升压模块的电感电流限流设置, 需要外接电容到地, 电容大小影响启动时间, 偏小容易引起启动大电流, 建议0.1uF电容。
9	COMP	I	升压模块的环路控制补偿, 外接电阻和电容网络。
10	FB	I	通过分压电阻设置升压HPVDD的电压。
11	LX	IO	升压模块开关连接电感。
12	LX	IO	升压模块开关连接电感。
13	HPVDDR	P	升压电压, 同时为功放功率右通道输出提供电源。
14	HPVDDR	P	升压电压, 同时为功放功率右通道输出提供电源。
15	OUTPR	O	右通道正端音频功率输出。
16	BSTPR	IO	右通道正端的自举电容, 需要连接0.22uF电容到OUTPR。
17	BSTNR	IO	右通道负端的自举电容, 需要连接0.22uF电容到OUTNR。
18	OUTNR	O	右通道负端音频功率输出。

19	OUTNL	O	左通道负端音频功率输出。
20	BSTNL	IO	左通道负端的自举电容，需要连接0.22uF电容到OUTNL。
21	BSTPL	IO	左通道正端的自举电容，需要连接0.22uF电容到OUTPL。
22	OUTPL	O	左通道正端音频功率输出。
23	HPVDDL	P	升压电压，同时为功放功率左通道输出提供电源。
24	HPVDDL	P	升压电压，同时为功放功率左通道输出提供电源。
25	EP	P	散热片连接内部功率地



极限工作条件(Note1)

符 号	说 明		范 围	单 位
V _{BAT}	电池电压 (V _{BAT} to GND)		-0.3 to 13V	V
V _{HPVDDL}	升压电压 (HPVDDL to GND)		-0.3 to 16V	
V _{HPVDDR}	升压电压 (HPVDDR to GND)		-0.3 to 16V	
LX	升压连接电感		17V	
V _{OUTP/N}	输出OUTP/N		-0.3 to 13V	
I/O	VCTRL		-0.3 to 13V	
	ILIMIT、COMP		-0.3 to 5V	
	INPL、INNLL、INPR、INNER、BTG		-0.3 to 5V	
I _{OUT}	功放输出端输出最大电流		5	A
P _d	最大功耗	ESSOP-24	400	mW
P _{TR}	封装热阻 θ_{JA}	ESSOP-24	°C /W	°C /W
T _J	结温度范围		-40 to +150	°C
T _{STG}	储存温度范围		-40 to +150	
T _{SDR}	焊接温度范围		260	

Note 1. 绝对最大额定值是指设备的寿命可能收到损坏的值，在绝对最大额定条件下有可能会引起芯片的永久性损伤。



推荐工作条件

符 号	说 明	最小值	最大值	单位
V _{BAT}	电源电池电压	2.8	13	V
V _{LX}	连接电感的LX侧电压		17	
T _A	环境温度	-40	85	°C
T _J	结温度范围	-40	125	
R _L	扬声器阻抗	3	8	Ω

电气特性

V_{BAT}=3.7V, 升压PVDD=9V, T_A= 25°C (典型情况)

符 号	参 数	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
I _{DD}	静态电流	V _{BAT} =3.7V, D 类模式		28		mA
I _{SD}	关断电流	V _{BAT} =3.7V, EN=0V		6		μA
F _{OSC1}	D类PWM频率	V _{BAT} =3.7V Class D mode		500		kHz
V _{OS}	输出直流偏差电压	R _L =4Ω			20	mV
V _N	噪声输出等效电压	With A-weighted Filter, 27dB R _L =4Ω,		85		μVrms
R _{DS(ON)}	静态导通电阻	P _{VDD} =7V, I _L =1A 上边		80		mΩ
		P _{VDD} =7V, I _L =1A 下边		80		
η	效率	P _O =2W, R _L =4Ω+33μH		82		%
		P _O =6W, R _L =4Ω+33μH		83		
THD+N	总谐波失真加噪声	THD+N=1%, f _{in} =1kHz RL=4Ω		9.0		W
		THD+N=10%, f _{in} =1kHz RL=4Ω		11		
S/N	信噪比	With A-weighted Filter P _O =2W, R _L =4Ω		85		dB
PSRR	电源抑制比	R _L =4Ω, f _{in} =217Hz, V _{RIIPPLE} =0.2V _{PP}		-80	-60	

V_{BAT}=7.4V, 升压PVDD=14.5V, T_A= 25°C (典型情况)

符 号	参 数	测 试 条 件	最小	典型	最大	单位
I _{DD}	静态电流	V _{BAT} =7.4V, D 类模式		13		mA
I _{SD}	关断电流	V _{BAT} =7.4V, EN=0V		7		μA
F _{OSC1}	D类PWM频率	V _{BAT} =7.4V Class D mode		500		kHz
V _{OS}	输出直流偏差电压	R _L =4Ω			20	mV
V _N	噪声输出等效电压	With A-weighted Filter, 27dB R _L =4Ω,		85		μVrms
η	效率	P _O =2W, R _L =4Ω+33μH		82		%
		P _O =6W, R _L =4Ω+33μH		83		



THD+N	总谐波失真加噪声	THD+N=1%, $f_{in}=1\text{kHz}$	$R_L=4\Omega$		24		W
		THD+N=10%, $f_{in}=1\text{kHz}$	$R_L=4\Omega$		25		
PSRR	电源抑制比	$R_L=4\Omega$, $f_{in}=217\text{Hz}$, $V_{RIPPLE}=0.2V_{PP}$			-80	-60	dB

$V_{BAT}=12V$, 升压PVDD=14.5V, $T_A=25^\circ\text{C}$ (典型情况)

符 号	参 数	测 试 条 件		最小	典型	最大	单位
I _{DD}	静态电流	V _{BAT} =7.4V ,D 类模式			12		mA
I _{SD}	关断电流	V _{BAT} =7.4V ,EN=0V			10		μA
F _{OSC1}	D类PWM频率	V _{BAT} =7.4V Class D mode			500		kHz
V _{OS}	输出直流偏差电压	R _L =4Ω				20	mV
V _N	噪声输出等效电压	With A-weighted Filter, 27dB R _L =4Ω,			85		μVrms
η	效率	P _O =2W, R _L =4Ω+33μH			82		%
		P _O =6W, R _L =4Ω+33μH			83		
THD+N	总谐波失真加噪声	THD+N=1%, fin=1kHz	R _L =4Ω		25		W
		THD+N=10%, fin=1kHz	R _L =4Ω		26		
PSRR	电源抑制比	R _L =4Ω, fin=217Hz, V _{RI} PPLE=0.2V _{PP}			-80	-60	dB

典型曲线 (TA=25°C)

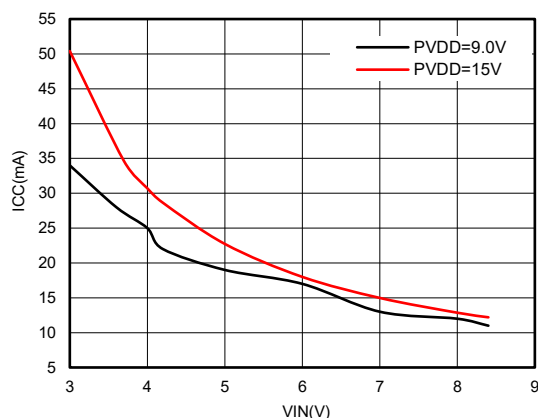


图3 输入电源电压和静态电流

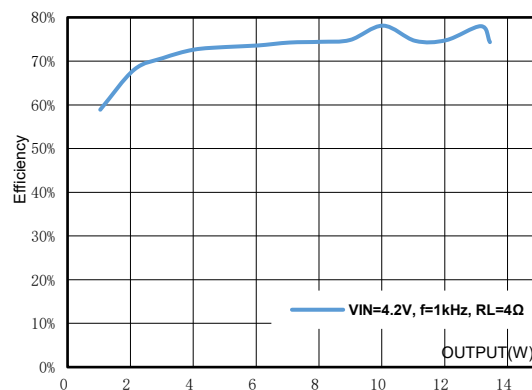


图4 输入4.2V, 输出9V时效率vs功率

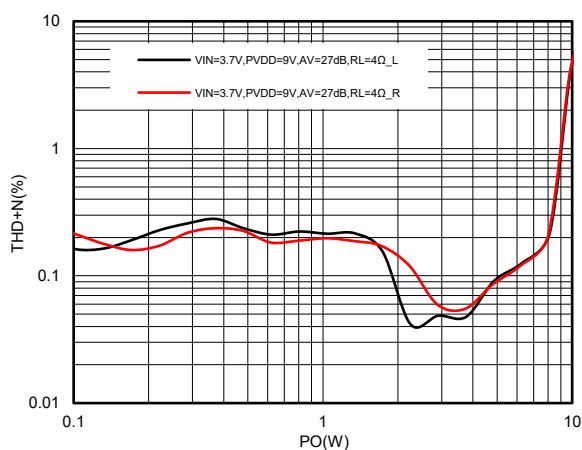


图5 VIN=3.7V, PVDD=9V时功率和失真THD+N (%)

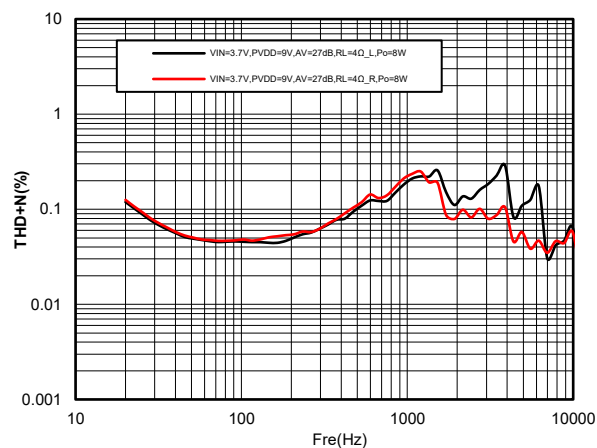


图6 VIN=3.7V, PVDD=9V时频率vs失真THD+N (%)

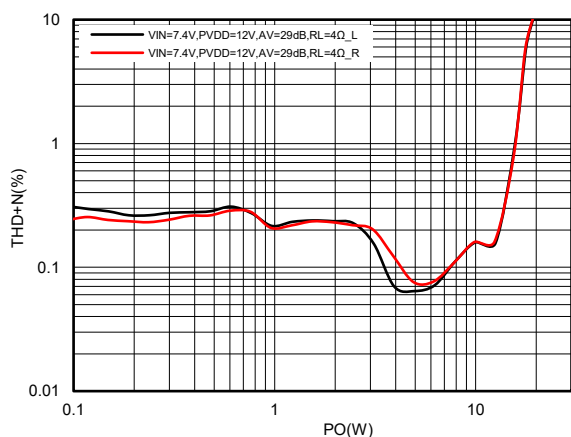


图7 VIN=7.4V, PVDD=12V时功率和失真THD+N (%)

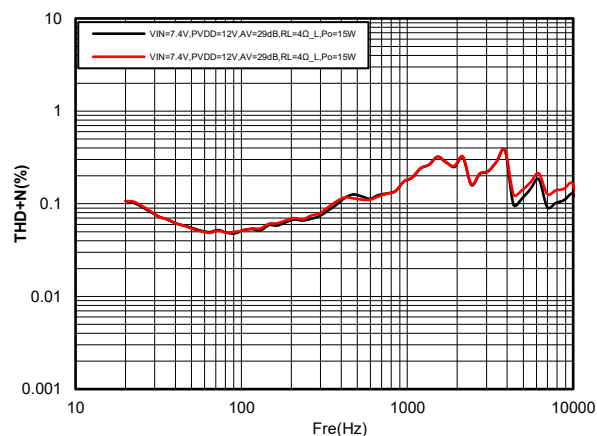


图8 VIN=7.4V, PVDD=12V时频率vs失真THD+N (%)

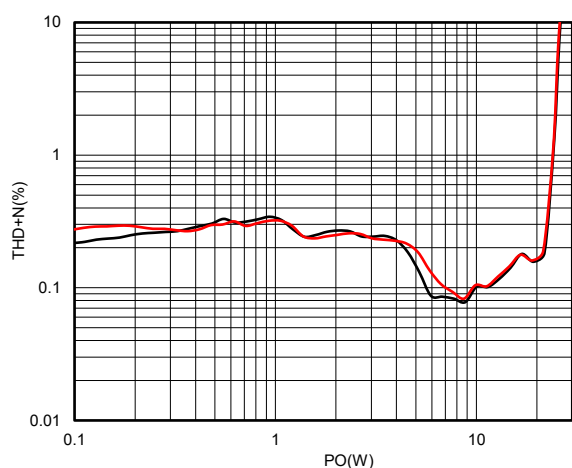


图9 $V_{IN}=7.4V$, $P_{VDD}=14.5V$ 时功率和失真THD+N (%)

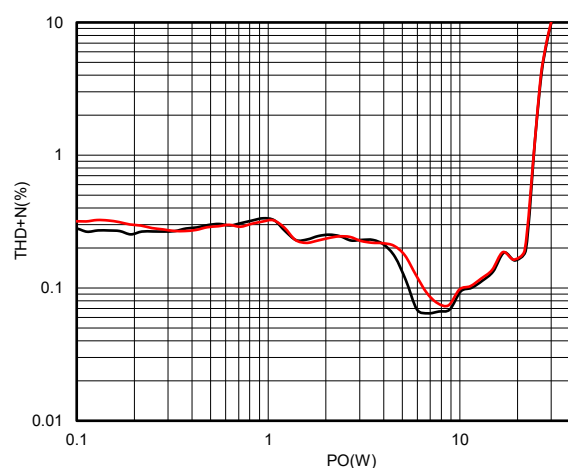


图10 $V_{IN}=12V$, $P_{VDD}=14.5V$ 时功率和失真THD+N (%)

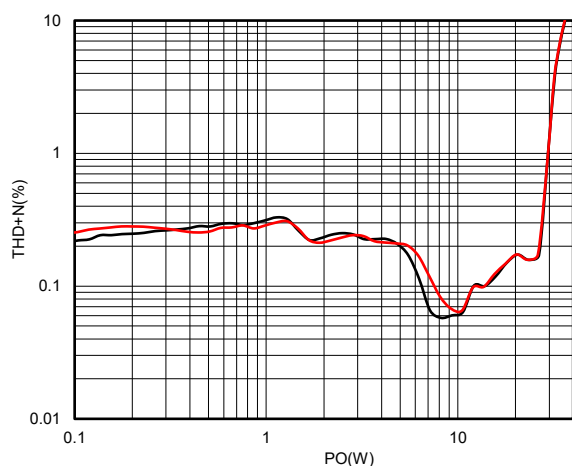
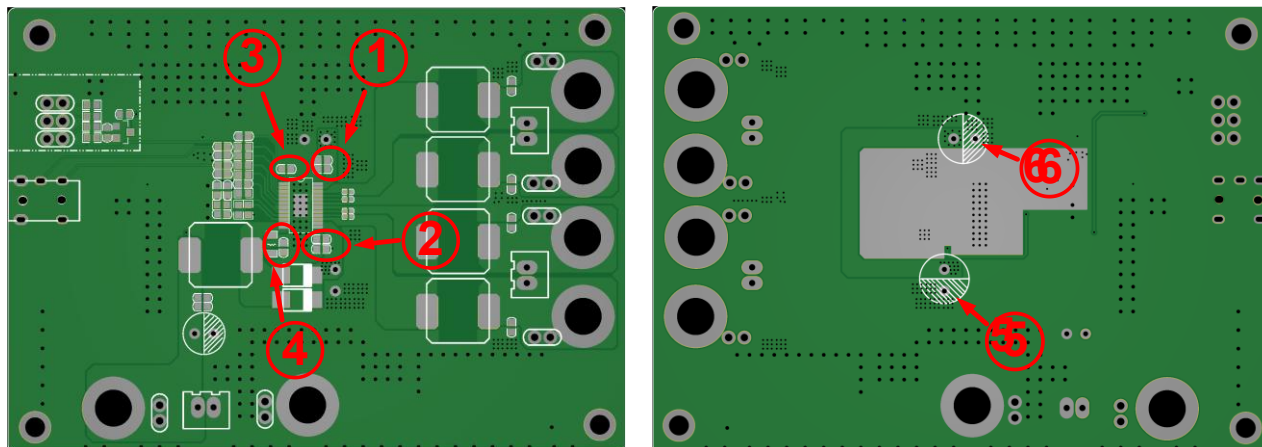


图11 $V_{IN}=12V$, $P_{VDD}=14.5V$ 时功率和失真THD+N (%)

应用指南

LTK54103是一款大功率、可设置升压、超低底噪、高效率、无滤波器立体声D类音频功率放大器。先进的扩频功能可以进一步降低EMI的辐射，甚至可以在不加任何磁珠的情况下满足要求。

PCB 注意事项



1. HPVDDL管脚陶瓷小电容（标识1）务必靠近芯片管脚放置，小电容另一端GND靠近芯片衬底，与芯片管脚连接不能使用过孔。
2. PVDDR管脚陶瓷小电容（标识2）务必靠近芯片管脚放置，小电容另一端GND靠近芯片衬底，与芯片管脚连接不能使用过孔。
3. VLDO的小电容务必靠近芯片管脚放置，小电容另一端GND靠近芯片衬底，与芯片管脚连接不能使用过孔。
4. LX处的RC组合的电容下地处，务必靠近芯片衬底的GND。
5. 电源输入的插件电解电容要靠近电感放置（标识5）；标识6处的电容靠近芯片管脚。
6. PCB在芯片底部开窗，与芯片衬底焊接，帮助芯片散热。
7. 连接FB的分压电阻R的升压电压，要从升压滤波电容后连接分压电阻R。
8. 为了降低系统的底噪和开机POP音，在使用差分输入模式时，使INN1、INPL和INN2、INPR的输入电阻、电容尽量匹配；在做单端输入使用时，有一端输入是交流接地的，建议把线拉到信号源端再接地，尽量使NN1、INPL和INN2、INPR的输入路径走线对称。
9. 应用在大电流输出时，要根据系统对电流的要求，选用并联的二极管，有利于保持电流能力的同时降低阻抗，提高可靠性和效率。

VCTRL 功能说明

VCTRL 是复合功能管脚，有扩频模式和关闭扩频模式，在扩频模式下可以具有更低的 EMI 特性，VCTRL 开关最少要有 100us 的间隔，可以通过增加 RC 实现延时。

VCTRL	状 态
<0.3V	关 断
1.7V-1.9V	扩频功能打开的 D 类模式
>2.1V	扩频功能关闭的 D 类模式

ILIMIT 功能说明

通过外接不同的 R_{limit} 电阻，可以限定输入的电感电流，从而根据电源电池和输出功率的要求灵活配置限流值。另外，外接电容的大小也会影响芯片升压的启动时间，电容太小会导致启动大电流，LTK54103 推荐使用 0.1uF 的电容。



R _{LIMIT}	电感电流
18kΩ	10A
15kΩ	8.0A
12kΩ	5.0A

* 限流电阻对应电流需要跟电感电流匹配，电感选取需要考虑电感电流能力，要大于芯片限流电阻对应的电流，否则容易引起芯片损坏或者卡顿。

过温保护 (OTP)

当检测到芯片内部温度超过预设的阈值 (160°C) 时，芯片会进入关闭输出的状态，当芯片内部温度返回到一个较低温度 (大约低于阈值20°C)，芯片将恢复到正常工作模式。

欠压保护功能

为使芯片安全可靠工作，LTK54103 具有欠压保护功能，欠压阈值在2.7V左右，当检测到电源电压低于V_{UVLO}时，启动欠压保护功能，这时会关闭芯片的输出，输出管脚会被拉到低电平；当检测到电源电压高于V_{UVLO}时，芯片将恢复到正常工作模式。

输入阻抗 R_i

LTK54103提供输入全差分结构，要求输入电阻之间良好的匹配（差分输入电阻阻值一致），可以提升PSRR、CMRR等性能。PCB布局时要尽可能靠近芯片的管脚位置。

在30dB的增益设置下，芯片内部的输入电阻：R_i=10.2kΩ；内部反馈电阻：R_f=330kΩ；R_{ex}是外置输入电阻，可以根据需要选用。

$$A_V = 20 \log * \frac{R_f}{R_{ex} + R_i} \quad (2)$$

LTK54103 的输入电容和输入电阻构成输入高通滤波器，通过选取合适的电容，来决定截止频率。

$$f_{C(Highpass)} = \frac{1}{2\pi R_i C_i} \quad (3)$$

电容的选取可以参考下面公式：

$$C_i = \frac{1}{2\pi R_i f_c} \quad (4)$$

输入电容 R_i

LTK54103 的输入电容和输入电阻构成输入高通滤波器，通过选取合适的电容，来决定截止频率。

$$f_{C(Highpass)} = \frac{1}{2\pi R_i C_i} \quad (2)$$

电容的选取可以参考下面公式：

$$C_i = \frac{1}{2\pi R_i f_c} \quad (3)$$

磁珠选择

选择磁珠时，要注意铁氧体材料类型，需要能在10~100MHz频率范围正常工作的磁珠，使用铁氧体磁珠过滤器，可以有效降低出现在扬声器和电源线30MHz频率以上范围的高频信号辐射。在铁氧体磁珠滤波器后面，接一个1nF高频电容到地可以进一步对高频信号旁路，来降低信号的频谱在一个可接受的水平。为了获得最佳性能，对铁氧体磁珠滤波器的谐振频率应小于10MHz。

选择铁氧体磁珠需要考虑三个重要指标：直流电阻 (DCR)、100MHz时的阻抗和额定工作电流，要求DCR小于50mΩ，100MHz的阻抗在100Ω~330Ω之间，额定电流在8Ω喇叭应用下不小于3A，4Ω喇叭应用下不小于5A，3Ω喇叭应用 (PBTl)

下不小于7A。

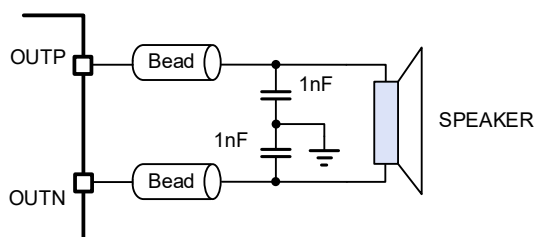


图13 差分磁珠滤波输出

LC 输出滤波器

在扬声器引线比较长并且对EMI要求很高的应用环境，需要一个LC输出滤波器以获得最佳的EMI抑制，LC滤波器的设计既要比音频信号的频率高，又要对音频信号频带内的信号没有影响，可以尽量地衰减音频范围外的高频信号。LC输出滤波器的转角频率通常选择在50kHz左右下面是一个二阶低通滤波器，如图14所示。

在公式（3）中， $L=L_1=L_2$ ； $C_2=C_3=C_L$ ； $C=2 \times C_1 + C_L$

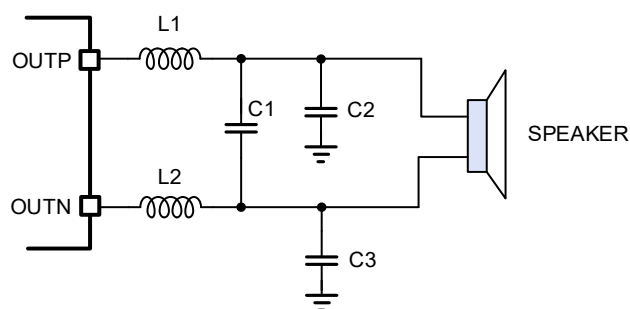


图14 差分LC滤波输出

同时因为LC输出滤波器的品质因数Q很重要，Q值太低会使转角频率附件的信号幅度衰减太多，Q值太高会使转角频率附件的信号幅度提升过多。LC输出滤波器的品质因数Q通常设置在0.7到1之间，但会随喇叭阻抗变化而变化。

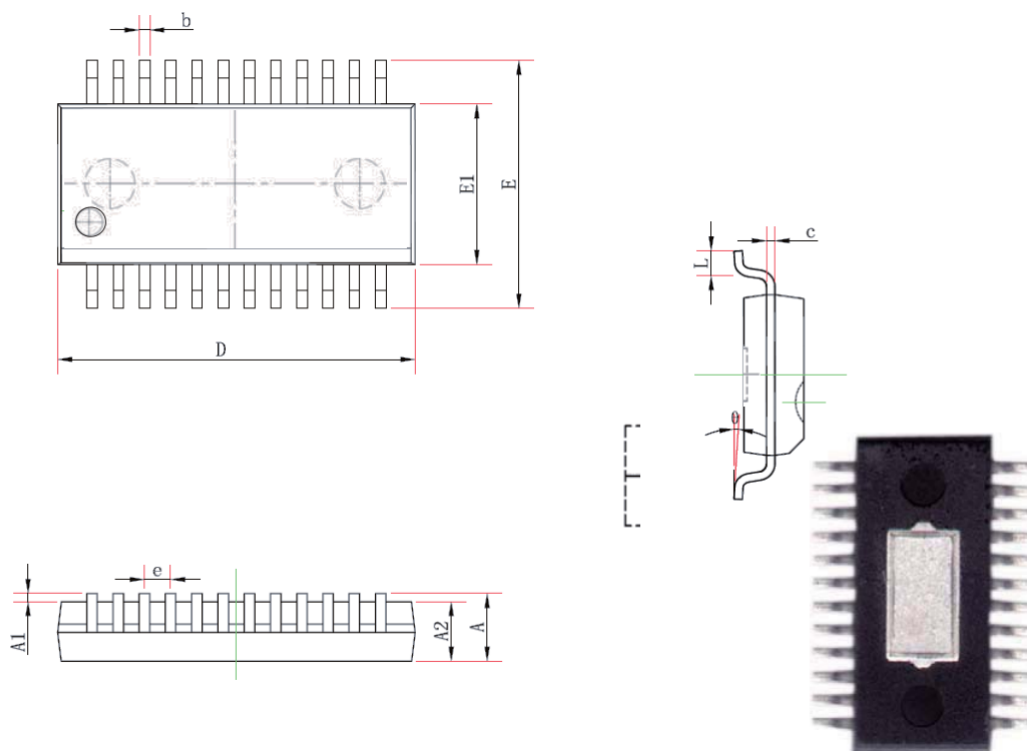
$$f_{C(\text{lowpass})} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4)$$

下表给出了喇叭负载在2、3、4、或8情况下建议的二阶低通滤波器L1、L2、C1、C2和C3的取值。

喇叭阻抗 (Ω)	L1, L2 (μH)	C1 (μF)	C2, C3 (μF)	$f_{c,LPF}$ (kHz)	Q值
8	22	0.33	0.68	41	0.70
4	10	0.56	1	50	0.63
3	6.8	0.68	1.5	50	0.70
2	4.7	1.0	2.2	50	0.68



ESSOP24 封装信息



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	—	1.750	—	0.069
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.250	—	0.049	—
b	0.203	0.305	0.008	0.012
c	0.102	0.254	0.004	0.010
D	8.450	8.850	0.333	0.348
E1	3.800	4.000	0.150	0.157
E	5.800	6.200	0.228	0.244
e	0.635 (BSC)		0.025 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

版本修改说明

No.	修改日期	版本	负责人	内 容
1	2025年12月02日	V1.0	Wilson Li	第一版本发布